

フレキシブルマイクロ LED の可能性

講師：藤岡 洋 氏 東京大学生産技術研究所 教授

マイクロ LED は有機 EL のディスプレイを置き換える次世代表示素子技術として大きな注目を集めている。マイクロ LED ディスプレーを実用化するためには、安価な大面積基板上に GaN-LED アレイを作製する技術を開発する必要があるが、本セミナーではスパッタリングによる窒化ガリウム成長技術を用いた大面積フレキシブルマイクロ LED 作製の可能性について、この分野に関する専門知識のない技術者にもわかるように平易に解説する

【講師経歴】 東京大学工学部卒、カリフォルニア大学バークレー校博士課程終了、富士通株式会社勤務、東京大学工学系研究科助手、講師、助教授を経て東京大学生産技術研究所教授

【研究歴】 Si 半導体集積回路製造プロセスに関する研究、化合物半導体結晶成長に関する研究、化合物半導体発光素子および電子素子に関する研究

【所属学会】 応用物理学会フェロー、日本結晶成長学会評議員、日本学術振興会結晶成長の科学と技術第 161 委員会委員長

開催日時	2019 年 6 月 20 日 (木) 13:30~16:30	【会場】 ちよだプラットフォームスクウェア ミーティングルーム 5F 会議室 503 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町 3-21
受講料	48,000 円 (税込) ※資料代含 * メルマガ登録者 43,000 円 (税込) * アカデミック価格 25,000 円 (税込)	

*アカデミック価格:学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、大学院の教員、学生に限りです。

★【メルマガ会員特典】 2 名以上同時申込で申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合、2 名目は無料、3 名目以降は半額です。

★【セミナーで得られる知識】 窒化物 LED を用いてマイクロ LED ディスプレーを実現するための現時点における技術的問題点、その解決策の一例としてのスパッタ成膜技術、今後の技術的展望など

【本セミナーのプログラム】

※適宜休憩が入ります。

1 開発の背景	3.1 スパッタ GaN LED 素子の特性
1.1 表示素子の技術的流れ	3.2 スパッタ GaN HEMT 素子の特性
1.2 マイクロ LED の重要性	3.3 スパッタ GaN MISFET 素子の特性
1.3 マイクロ LED 製造の技術的問題点	3.4 スパッタ GaN パワー素子の特性
1.4 スパッタ GaN 成長技術の利点	3.5 スパッタ GaN 受光素子の特性
2 スパッタ法による GaN の成長技術	4 スパッタ法を用いて低価格基板上に試作した GaN 素子の特性
2.1 スパッタ GaN 薄膜の構造的特徴	4.1 GaN 成長用低価格基板
2.2 スパッタ GaN 薄膜の電気的特徴	4.2 金属フォイル上に作製した GaN LED 素子
2.3 スパッタ GaN 薄膜の光学的特徴	4.3 ガラス基板上に作製した GaN LED 素子
3 スパッタ法を用いて試作した GaN 素子の特性	4.4 ポリマーフィルム上に作製した GaN 素子

弊社記入欄		セミナー申込書	
セミナー名		フレキシブルマイクロ LED の可能性	
所定の事項にご記入下さい メルマガ会員、 登録希望の場合は○↓		会社名 (団体名) 住 所 〒	TEL : FAX : E-mail :
会員登録 済み	新規 登録希望	部署	役職
お支払方法		銀行振込・その他	氏 名
		お支払予定	2019 年 月 日頃

■申込方法：セミナー申込書にご記入の上 FAX または E-mail (re@cmcre.com) でお申し込みください。

■セミナーお申込み後のキャンセルは基本的にお受けしておりません、ご都合により出席できなくなった場合は代理の方がご出席ください。

■申込先：(株)シーエムシー・リサーチ 東京都千代田区神田錦町 2-7 TEL 03-3293-7053

■本セミナーの関連情報は、弊社HPでもご覧いただけます。⇒ <http://www.cmcre.com>

参加申込 FAX 番号
03-3291-5789